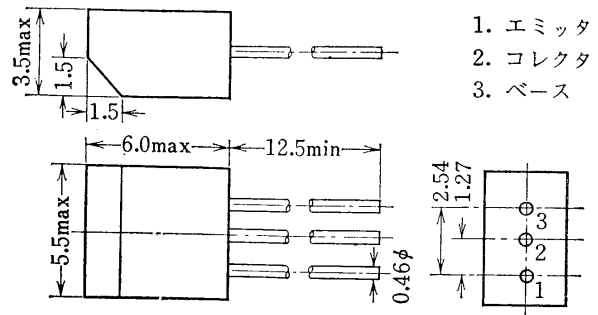


# 2SC458

シリコン NPN プレーナ形  
低周波増幅用



### ■ 最大定格 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	.....	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	.....	30	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	.....	5	V
コレクタ電流	$I_C$	.....	100	mA
許容コレクタ損失	$P_O$	.....	200	mW
接合部温度	$T_j$	.....	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	.....	-55~+125	$^\circ\text{C}$

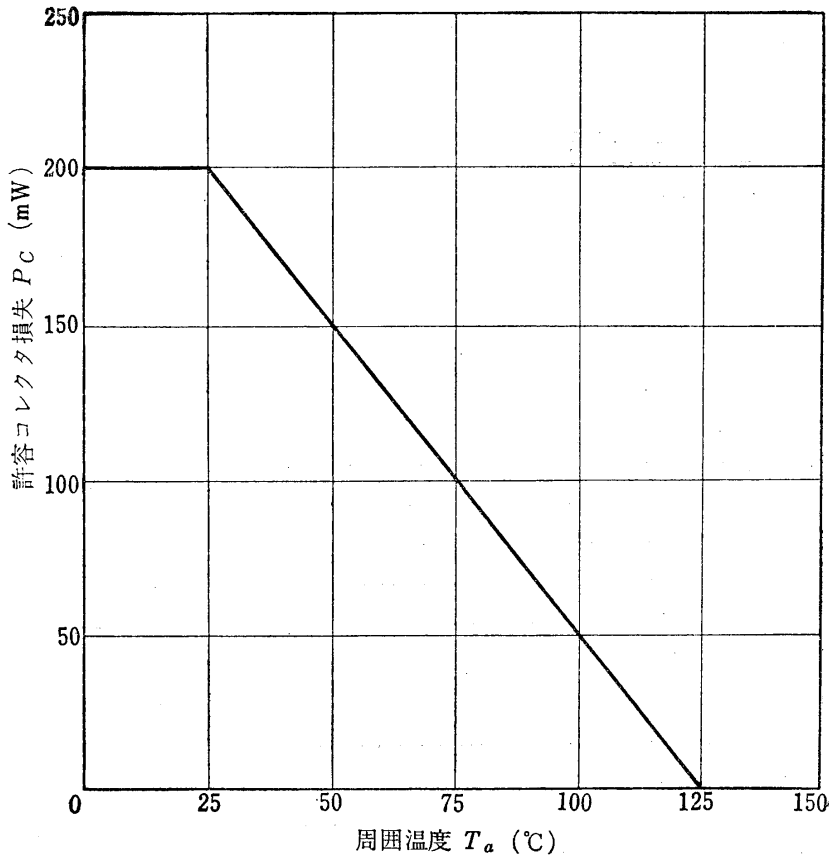
### ■ 電気的特性 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

	最小	標準	最大	
コレクタ・ベース破壊電圧 $BV_{CBO}$ ( $I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$ )	30	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧 $BV_{CEO}$ ( $I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$ )	30	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧 $BV_{EBO}$ ( $I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$ )	5	—	—	V
コレクタ遮断電流 $I_{CBO}$ ( $V_{CB}=18\text{V}, I_E=0$ )	—	—	0.5	$\mu\text{A}$
エミッタ遮断電流 $I_{EBO}$ ( $V_{EB}=2\text{V}, I_C=0$ )	—	—	0.5	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率*				
$h_{FE}$ ( $V_{CE}=12\text{V}, I_C=2\text{mA}$ )	60	—	320	
ベース・エミッタ電圧 $V_{BE}$ ( $V_{CE}=12\text{V}, I_C=2\text{mA}$ )	—	0.65	0.75	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ ( $I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$ )	—	0.15	1.1	V
雑音指数 $NF$ ( $V_{CE}=6\text{V}, I_C=0.1\text{mA}, f=1\text{kc}, R_g=500\Omega$ )	—	8	15	dB
小信号入力インピーダンス $h_{ie}$ ( $V_{CE}=12\text{V}, I_E=-2\text{mA}, f=270\text{c/s}$ )	—	2.8	—	$\text{k}\Omega$
小信号電圧帰還率 $h_{re}$ ( " )	—	0.7	—	$\times 10^{-4}$
小信号電流増幅率 $h_{je}$ ( " )	—	160	—	
小信号出力アドミタンス $h_{oe}$ ( " )	—	20	—	$\mu\text{S}$

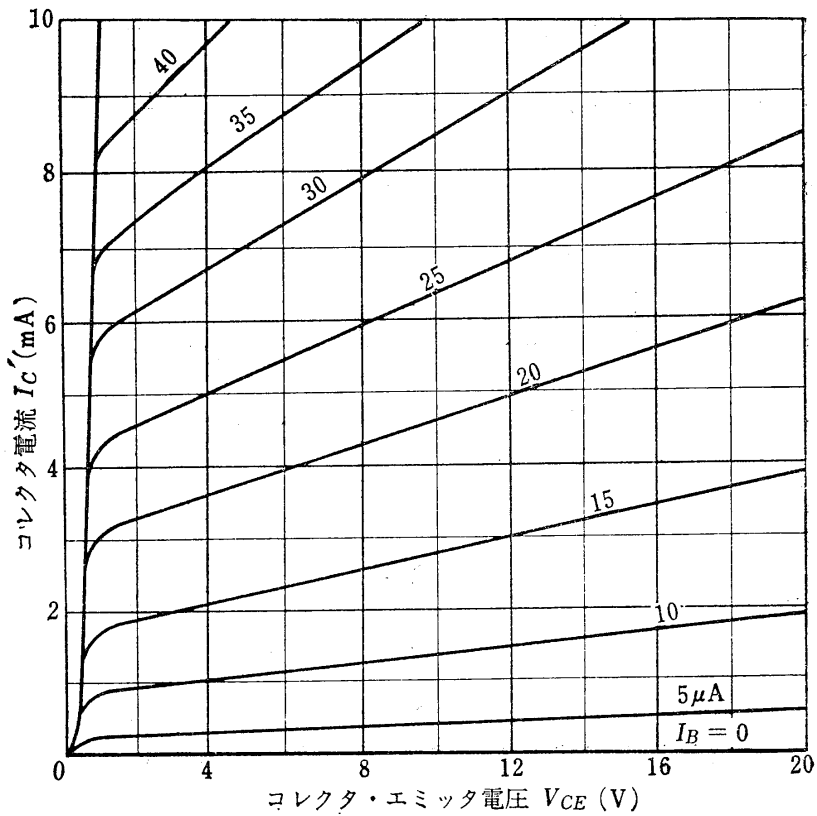
\* 2SC458 は  $h_{FE}$  の値により下記のように3区分し現品にそれぞれⒶ, Ⓑ, Ⓒと表示してあります。

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
60~120	100~200	160~320

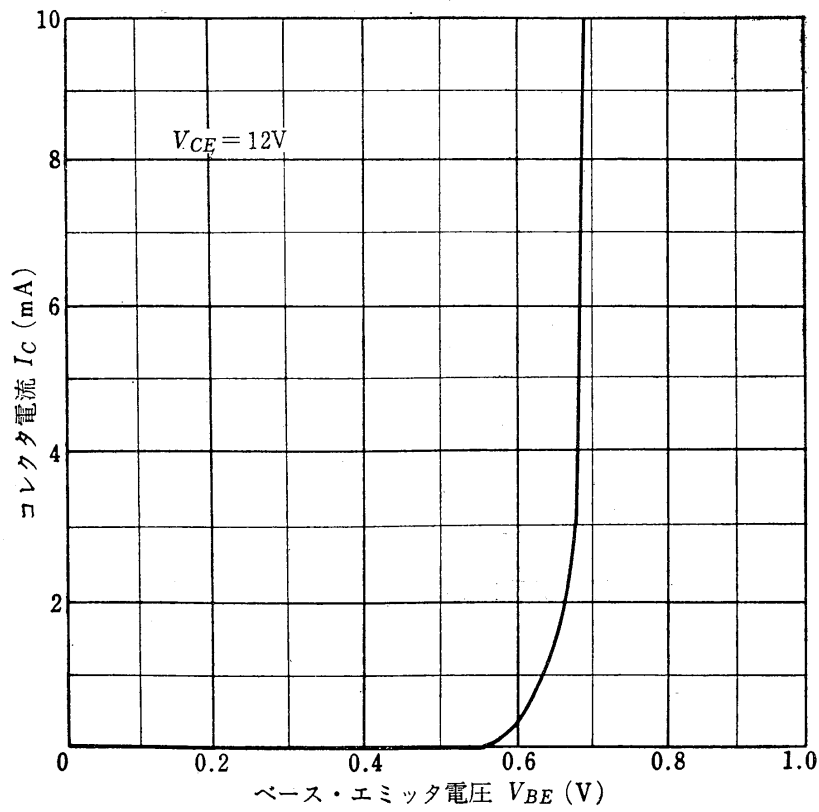
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



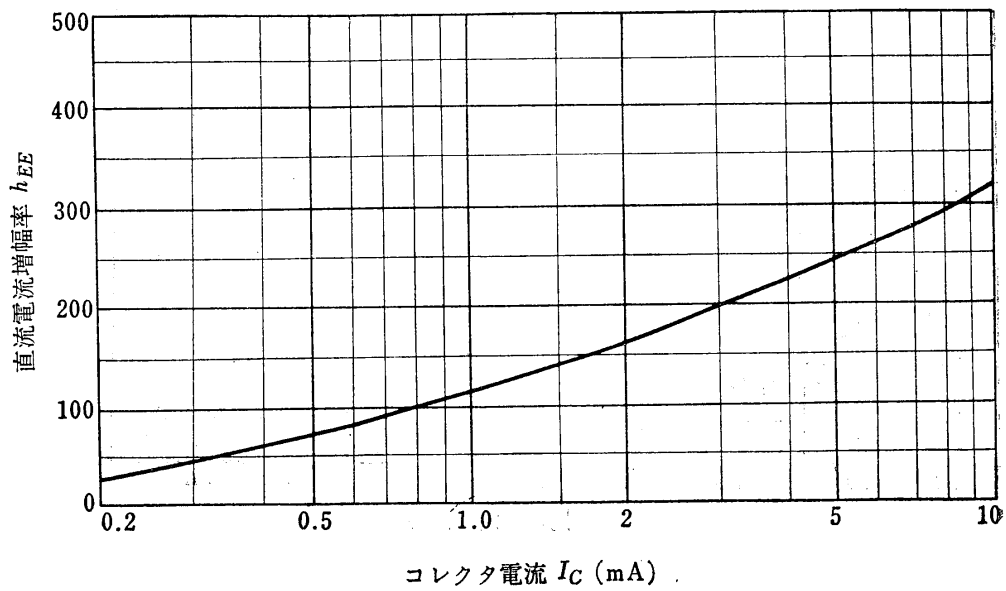
エミッタ接地出力静特性



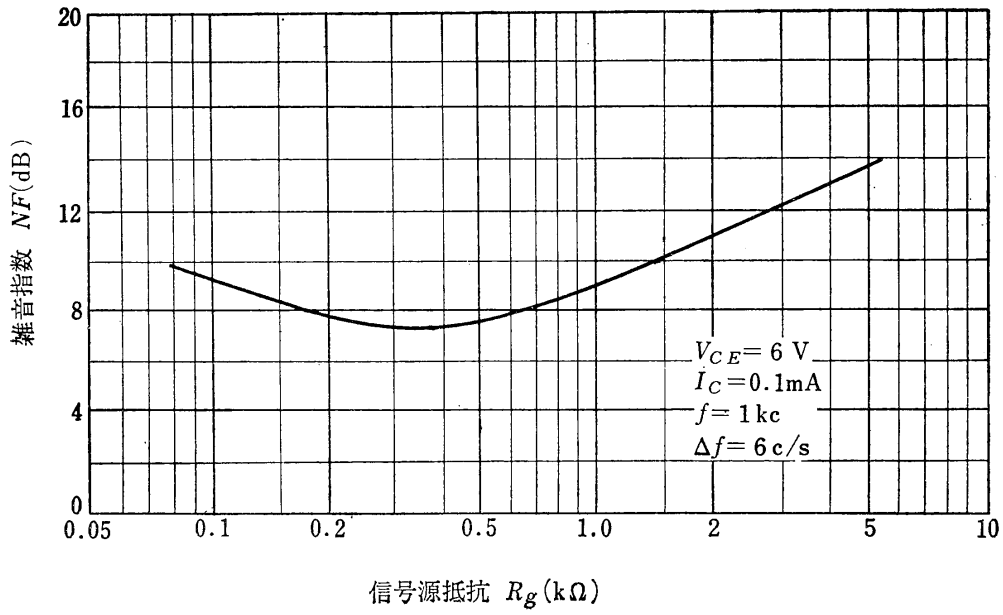
エミッタ接地伝達静特性



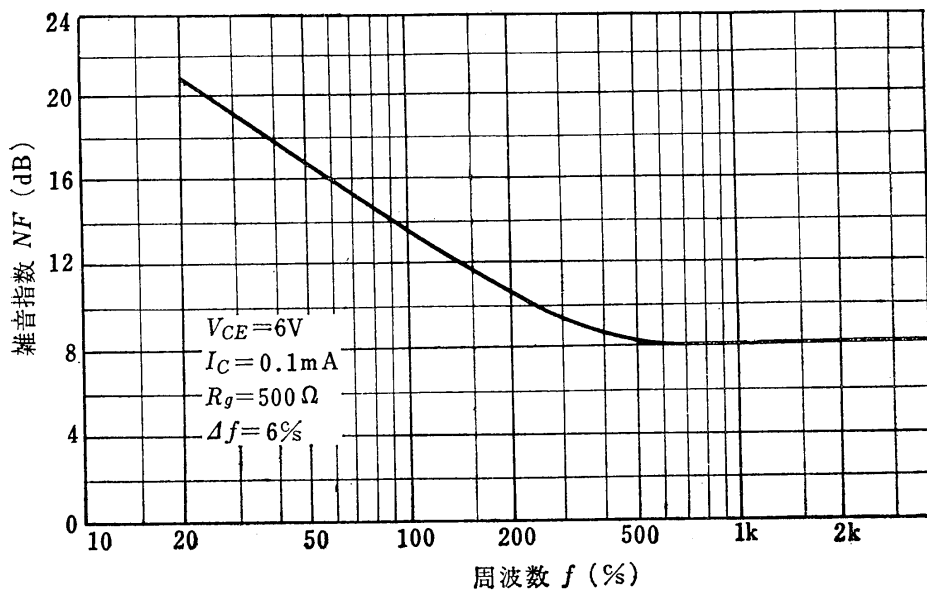
直流電流増幅率対コレクタ電流特性



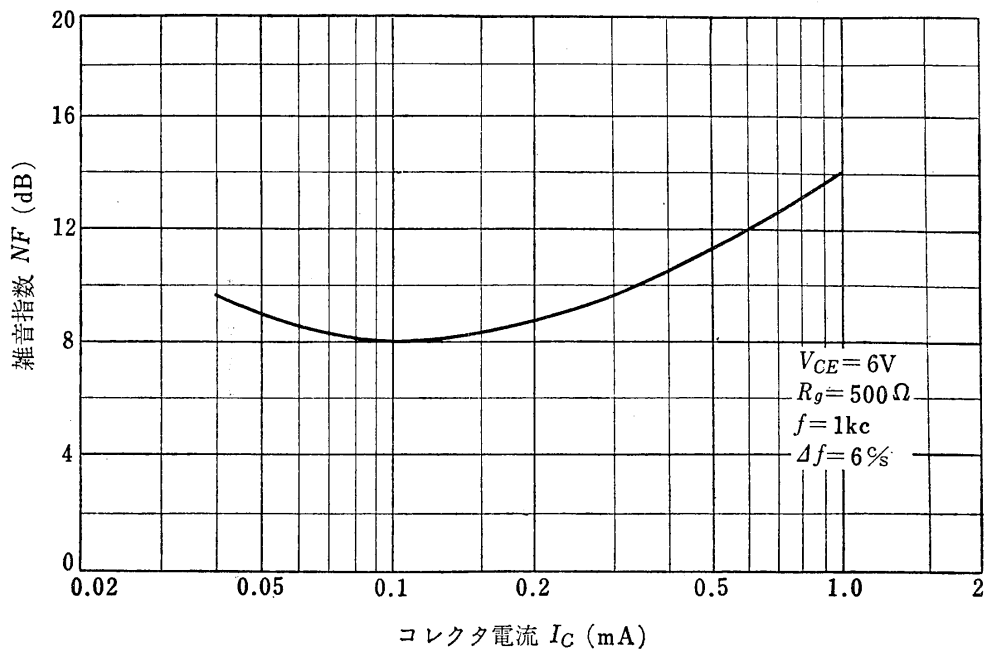
雜音指数对信号源抵抗特性



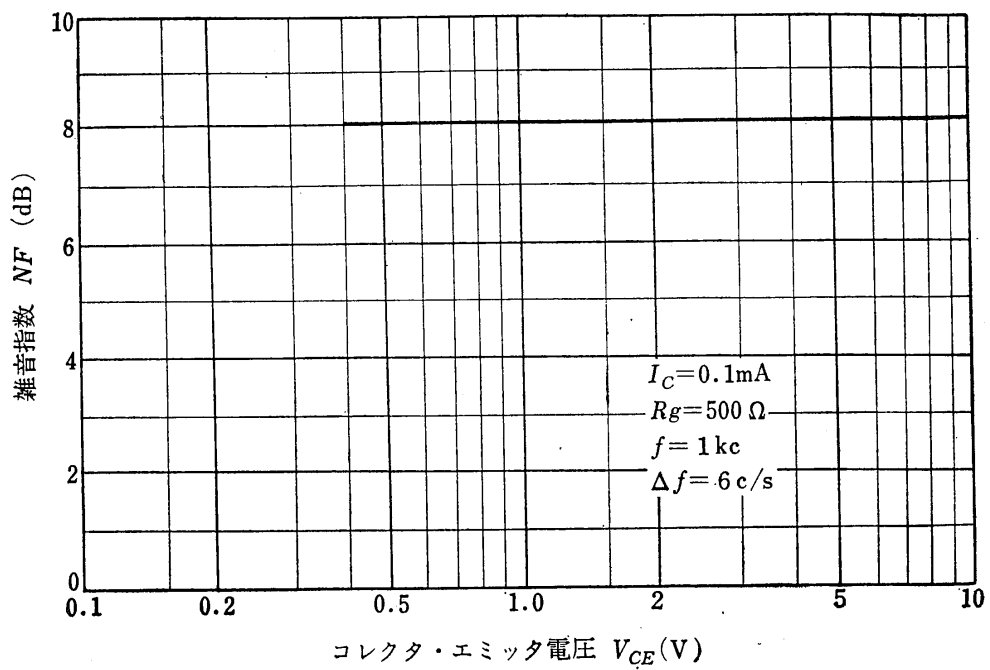
雜音指数对周波数特性



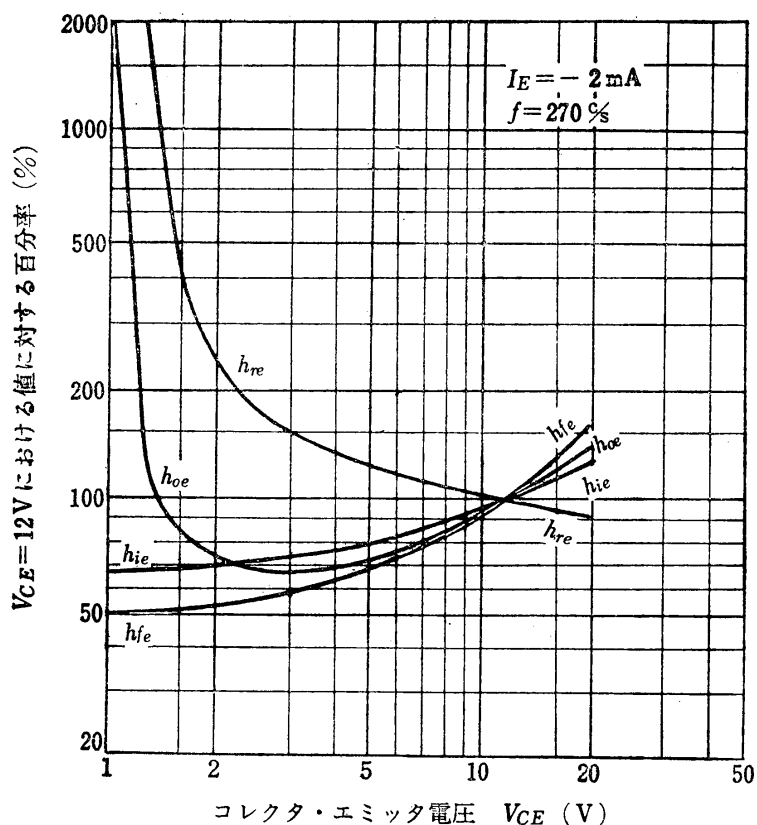
## 雑音指数対コレクタ電流特性



## 雑音指数対コレクタ・エミッタ電圧特性



h 定数対コレクタ・エミッタ電圧特性



h 定数対エミッタ電流特性

